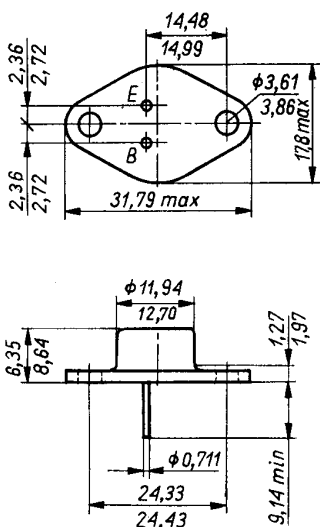


Tranzystory germanowe stopowe średniej mocy małej częstotliwości. Są przeznaczone do stosowania we wzmacniaczach akustycznych średniej mocy. Do układów przeciwobrotnych tranzystory są dobrane parami.

sl 7



Tranzystor w obudowie metalowej TO66(CE24). Kolektor jest połączony z obudową.

DANE TECHNICZNE

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych

Typ		ADP665	ADP666	
Napięcie kolektor-baza	$-U_{CB0}$	30	60	V
Napięcie kolektor-emiter	$-U_{CES}$	30	60	V
Napięcie kolektor-emiter	$-U_{CE0}$	15	30	V
Napięcie emiter-baza	$-U_{EB0}$	10	10	V
Prąd kolektora	$-I_C$	1,5	1,5	A
Prąd emitera	I_E	1,5	1,5	A
Prąd bazy	$-I_B$	0,25	0,25	A
Temperatura złącza	t_j	348 K (75°C)		
Zakres temperatury składowania	t_{stg}	218...348 K (-55...+75°C)		
Moc strat kolektora przy $t_{case} = 298$ K (+25°C)	P_C	5	5	W

2 Elementy półprzewodnikowe

SWW 1156-221

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna

złącze-otoczenie	$R_{th(j-a)}$	≤66	≤66	K/W
złącze-obudowa	$R_{th(j-c)}$	≤10	≤10	K/W

TRANZYSTOR ADP665

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)

min. typ. maks.

Współczynnik wzmocnienia prądowego

przy $-I_C = 0,1$ A,
 $-U_{CE} = 6$ V h_{21E}

20 — 120 —

przy $-I_C = 1$ A,
 $-U_{CE} = 1$ V h_{21E}

12 — — —

Prąd zerowy kolektora

przy $-U_{CB} = 12$ V $-I_{CB0}$

— 10 50 μA

przy $-U_{CB} = 12$ V,
 $t_{amb} = 343$ K (70°C) $-I_{CB0}$

— 260 500 μA

Prąd zerowy emitera

przy $-U_{EB} = 6$ V $-I_{EB0}$

— 8 50 μA

Napięcie przebicia kolektor-baza

przy $-I_C = 200$ μA,
 $I_E = 0$

$-U_{(BR)CB0}$ 30 — — V

Napięcie przebicia kolektor-emiter

przy $-I_C = 200$ μA,
 $R_{BE} = 0$

$-U_{(BR)CES}$ 30 — — V

przy $-I_C = 0,2$ A,
 $-I_B = 0$

$-U_{(BR)CE0}$ 15 — — V

Napięcie przebicia emiter-baza

przy $-I_E = 100$ μA,
 $-I_C = 0$

$-U_{(BR)EB0}$ 10 — — V

Napięcie przebicia emiter-baza

przy $-I_E = 100$ μA,
 $-I_C = 0$

$-U_{(BR)EB0}$ 10 — — V

Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)

min. typ. maks.

Częstotliwość graniczna

przy $-U_{CB} = 6$ V,
 $-I_C = 0,1$ A,
 $f = 100$ kHz

f_T 0,1 0,38 — MHz

Stosunek współczyn-
ników wzmacnienia
prądowego dobra-
nych par *

przy $-U_{CE} = 6 \text{ V}$, $-I_C = 0,1 \text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—
przy $-U_{CE} = 1 \text{ V}$, $-I_C = 1 \text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—

TRANZYSTOR ADP666

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298 \text{ K}$ (25°C)		min.	typ.	maks.	
Współczynnik wzmacnienia prą- dowego					
przy $-I_C = 0,1 \text{ A}$, $-U_{CE} = 6 \text{ V}$	h_{21E}	20	—	120	—
przy $-I_C = 1 \text{ A}$, $-U_{CE} = 1 \text{ V}$	h_{21E}	12	—	—	—
Prąd zerowy kolek- tora					
przy $-U_{CB} = 12 \text{ V}$	$-I_{CB0}$	—	10	50	μA
przy $-U_{CB} = 12 \text{ V}$, $t_{amb} = 343 \text{ K}$ (70°C)	$-I_{CB0}$	—	260	500	μA
Prąd zerowy emitera					
przy $-U_{EB} = 6 \text{ V}$	$-I_{EB0}$	—	10	50	μA
Napięcie przebicia kolektor-baza					
przy $-I_C = 200 \mu\text{A}$, $-I_E = 0$	$-U_{(BR)CB0}$	60	—	—	V

Napięcie przebicia
kolektor-emiter

przy $-I_C = 200 \mu\text{A}$, $R_{BE} = 0$	$-U_{(BR)CES}$	60	—	—	V
przy $-I_C = 0,2 \text{ A}$, $-I_B = 0$	$-U_{(BR)CE0}$	30	—	—	V

Napięcie przebicia
emiter-baza

przy $-I_E = 100 \mu\text{A}$, $-I_C = 0$	$-U_{(BR)EB0}$	10	—	—	V
---	----------------	----	---	---	---

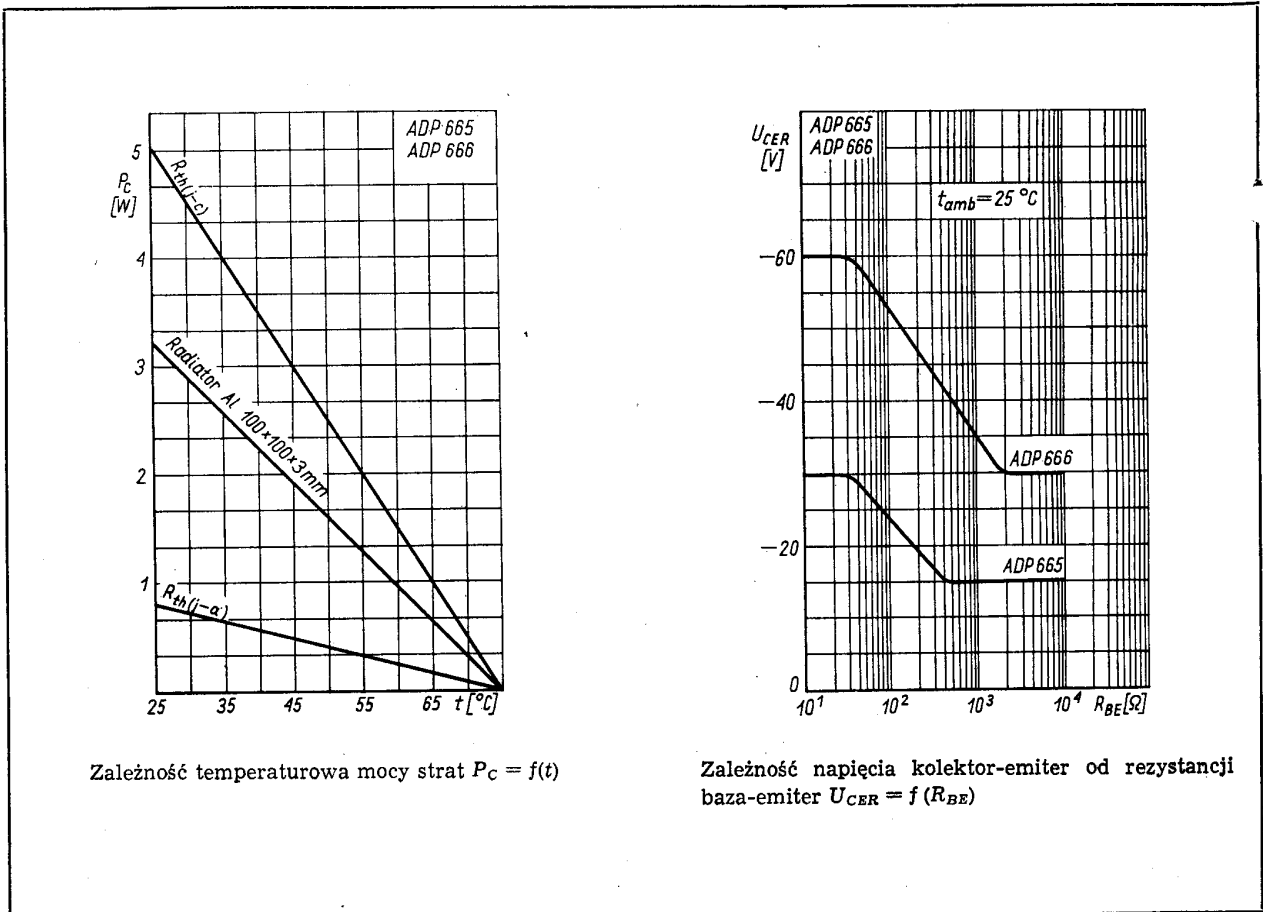
Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298 \text{ K}$ (25°C)		min.	typ.	maks.	
Częstotliwość gra- niczna					
przy $-U_{CB} = 6 \text{ V}$, $-I_C = 0,1 \text{ A}$, $f = 100 \text{ kHz}$	f_T	0,1	0,38	—	MHz

Stosunek współczyn-
ników wzmacnie-
nia prądowego do-
branych par *

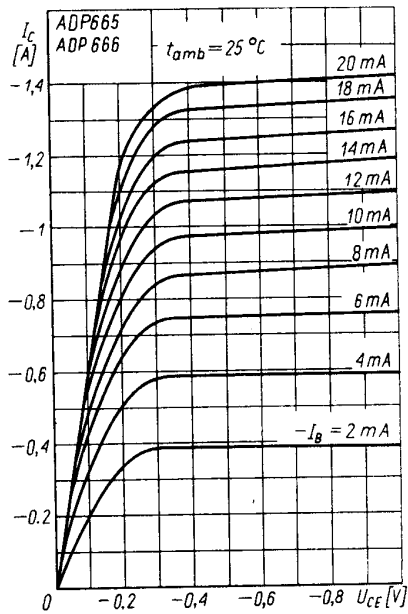
przy $-U_{CE} = 6 \text{ V}$, $-I_C = 0,1 \text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—
przy $-U_{CE} = 1 \text{ V}$, $-I_C = 1 \text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—

* Tranzystory dobiera się w pary na życzenie odbiorcy określo-
ne w zamówieniu.

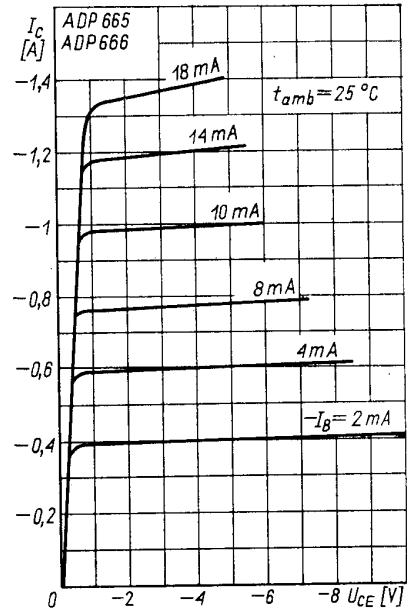


Zależność temperaturowa mocy strat $P_C = f(t)$

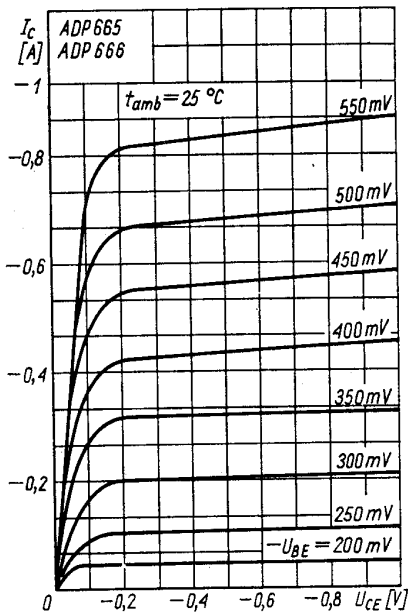
Zależność napięcia kolektor-emiter od rezystancji
baza-emiter $U_{CER} = f(R_{BE})$



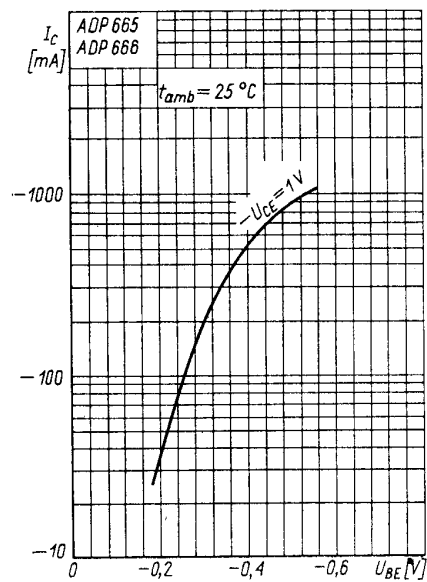
Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; I_B — parametr



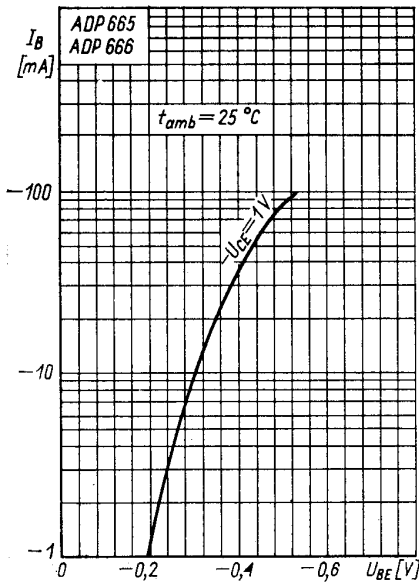
Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; I_B — parametr



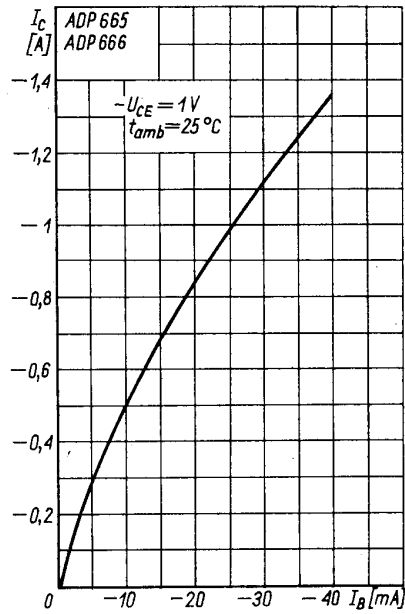
Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; U_{BE} — parametr



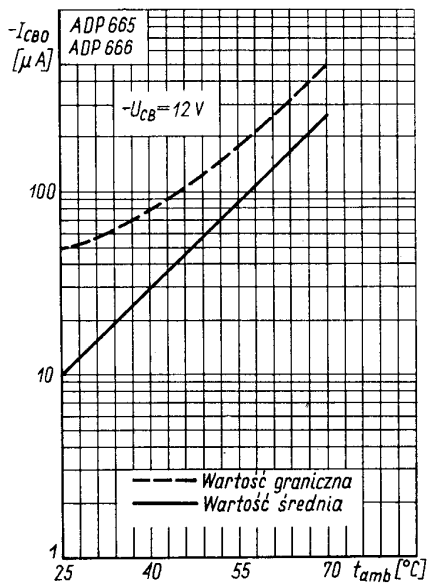
Zależność prądu kolektora $I_C = f(U_{BE})$



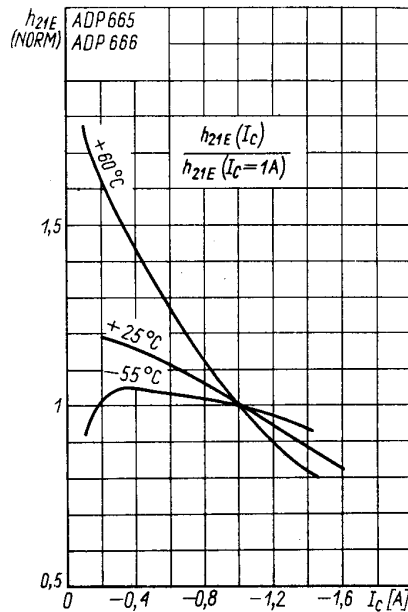
Charakterystyka wejściowa $I_B = f(U_{BE})$; U_{CE} — parametr



Charakterystyka przejściowa $I_C = f(I_B)$



Zależność temperaturowa prądu zerowego $I_{CB0} = f(t_{amb})$



Zależność statycznego współczynnika wzmocnienia prądowego znormalizowanego od prądu kolektora $h_{21E(m)} = f(I_C)$

PRODUCENT



NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
PÓLPRZEWODNIKÓW „TEWA”
ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431
Teleks: 813219

DYSTRYBUTOR



BIURO ZBYTU SPRZĘTU
TELERADIOTECHNICZNEGO
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435



LittleDiode supplies new, hard to find or obsolete electronic components and semiconductors all over the world.

With over two million different components listed you are sure to find the part you need.

Feel free to visit us today at our online store:

LittleDiode.com

Looking forward to providing you with the best possible service.